

سال پنجم 🔳 شمارہ ٤ 🖬 زمستان ۱۳۹۶ 🔳 شمارہ پیاپی ۲۰

ISSN 2538-3450

اصول و مفاهیم طیفسنج فوتوالکترون پرتو ایکس



معرفی آشکارساز الکترونهای برگشتی در میکروسکوپهای الکترونی روبشی



مروری بر روشهای یونیزاسیون مستقیم در طیفسنج جرمی



کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

12



همکاری حرفهای بیش از ۵۴۰ کارشناس و متخصص در کارگروههای تخصصی شبکه آزمایشگاهی

www.IJLK.ir info@ijlk.ir



عملكرد سيستم اپتيكى - الكترونى لنز تمام میکروسکوپ های الکترونی روبشی، کانونی کردن پرتوی الكترونى نشر شده از تفنگ الكترونى بهصورت باريكهاى ظریف روی سطح نمونهی هدف، جایی که برهم کنشهای الكترون - نمونه باعث توليد سيگنالهاى نشر مشخصى می شوند، است. جریان باریکه ی الکترونی و قدرت سیگنال نشرهای مختلف، با منبع تولید الکترون و سیستم لنزهای متمرکز کننده ۲۰ تعیین می شوند. این در حالی است که قطر باریکه و توانایی قدرت تفکیک^{۱۱}، بهطور کلی با شکل هندسی تفنگ الکترونی و لنزهای نهایی^{۱۲} تعیین می شوند. در عمل، بهبود قدرت تفکیک تنها زمانی ممکن است که جریان باریکه افزایش یابد که در نتیجهی آن، حداکثر جریان باریکه برای اندازهی داده شده محدود می شود. سیگنال نشرهای متفاوت از برهم کنشهای الكترواستاتيك بين باريكه يا الكترونهاي ورودى يا اوليه و نمونهی هدف ناشی میشود. بعضی از این برهم کنشها از نوع غیرالاستیک (مانند نشر الکترون های ثانویه) و بعضی دیگر الاستیک (مانند نشر الکترونهای برگشتی) هستند. هر سیگنال از یک حجم نشر مشخصی از داخل نمونهی هدف تولید می شود که اندازهی هر کدام به عمق نفوذ الكترونهاى باريكهى الكتروني، انرژى باريكه (ولتاژ شتاب دهنده)، قطر و مورفولوژی باریکه، ترکیب و ساختار بلوری نمونه بستگی دارد. در صورتی که باریکهی الکترونی به داخل نمونه نفوذ كند، دافعهى الكتروني بيشتري ايجاد می شود که این امر باعث کاهش قدرت تفکیک و کاهش قدرت سیگنال الکترونهای نشر شده می شود. بنابراین، طيف انرژی الکترونهای نشر شده شامل سه ناحیه مجزا است:

۱. الکترونهای متفرق شده بهصورت الاستیک با انرژیهای مشابه انرژی باریکه الکترونی (E₀). ۲. الکترونهای متفرق شده با انرژی بین E₀ تا ۵۰ ۵۰. ۳. الکترونهای کم انرژی (۵۰ ≤ v). الکترونهای ثانویه در گروه (۳) جای میگیرند در حالی که الکترونهای برگشتی، طبق قاعده باید در گروه (۱) قرار



چکیدہ

برهم کنش پرتوی الکترونی شتاب داده شده^۵ به نمونهی هدف^۶، انواع مختلفی از برخوردهای الاستیک^۷ و غیر الاستیک^۸ بین الکترونها و اتمهای نمونه را ایجاد میکند. پراکندگی الاستیک، مسیر پرتو الکترونی اولیه را هنگام برهم کنش با نمونهی هدف بدون تغییر قابل توجهی در انرژی جنبشی آنها، تغییر میدهد [۱]. الکترونهای برگشتی^۹، الکترونهای اولیهای هستند که از سطح نمونه با پراکندگی الاستیک بازگشت داده شدهاند. آشکارسازهای BSE، الکترونهایی را که بهصورت الاستیک پراکنده شدهاند، جمع آوری میکند. این آشکارسازها در بیشتر موارد در بالای نمونه قرار بهصورت الاستیک پراکنده شدهاند، جمع آوری میکند. داده میشوند و برای جمع آوری الکترونهای برگشتی داده میشوند و برای جمع آوری الکترونهای برگشتی نمونه منتشر میشوند، به کار میرود.

واژەھاي كليدى

الکترونهای برگشتی، پراکندگی الاستیک، کنتراست تصویر، میکروسکوپ الکترونی روبشی. www.IJLK.i

معرفي آشكارساز الكترونهاي برگشتي در ميكروسكوپهاي الكتروني روبشي

گیرند. همچنین به علت اثرات ناچیز غیرالاستیک، بخش عمدهای از الکترونهای گروه (۲) نیز بهصورت الکترونهای برگشتی نشر میشوند.

میکروسکوپهای الکترونی رایج، از مشخصههای نشر الكترونهاى ثانويهى سطوح ناهموار براى توليد تصاوير مبتنی بر توپوگرافی سطح استفاده میکنند. تصاویر الکترونهای ثانویه^{۱۳} در بزرگنماییهای خیلی بالاتر از آنچه که در میکروسکوپهای نوری ممکن بود، بهدست میآیند، این در حالی است که تلفیق مناسب تجهیزات میکروآنالیتیکی پرتو ایکس (چه بهصورت پراش انرژی یا به صورت پراش طول موج) تشخیص همزمان ترکیب شیمیایی نمونه را نیز امکانپذیر میکند. سالهاست که این ویژگیها، SEM را به دستگاهی محبوب در تحقیقات علوم پایه و مهندسی تبدیل کرده است. اما تصاویر مبتنی بر نشر الكترونهاى اوليه برگشتى نيز مورد توجه زياد دانشمندان و محققان قرار گرفته است. BSE از داخل نمونهی هدف تولید می شود و قادر به تهیهی تصاویری مبنی بر ترکیب شیمیایی و ساختار بلوری است. ویژگیهای BSE از SE متفاوت است و این امر باعث شدهاست که برای تهیهی تصاویر مبتنی بر BSE به دستگاه آشکارساز مجزا، آمادهسازی نمونه و تفسیر متفاوت تصاویر نیاز باشد. این مقاله به معرفی آشکارساز BSE، روش و جنبههای مختلف آن اشاره دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

نشر و تشخیص الکترونهای برگشتی BSE

∎ نشر BSE

الکترون های برگشتی BSE، الکترون های اولیه ای هستند که از سطح نمونه به دو طریق به صورت تفرق الاستیک برگشت داده می شوند:

۱. میـدان کولمـب قـوی هسـتهی اتمـی کـه میتوانـد باعـث تولیـد سـیگنال بـه بزرگـی (۹۰ ≥) بـا انحـراف در مسـیر پرتـوی اولیه شـود.

۲. پرتوهای اولیـه کـه میتواننـد متحمـل انحرافهـای کـم زاویـه چندگانـه شـوند کـه بـا هـم شـامل یـک انحـراف ≥ ۹۰ میشـوند.

هـر دو نـوع تفـرق، باعـث توليـد BSE بـا انرژىهـاى مختلـف مىشـود كـه برخـى از آنان انـرژى تا حـدى كمتر از انـرژى پرتوى ورودى اوليـه دارنـد و كمـى از پراكندگى غيرالاسـتيك را بهصورت جزئى شـامل مىشـوند.

شـکل حجـم اندرکنـش^{۱۴} بیـن پرتوهـای ورودی اولیـه و نمونـهی هـدف توسط وانکـوب و شـیلدر در سـال ۱۹۶۳ پیشبینـی شـده بـود. الکترونهـای پرتـو بـا انـرژی مشـابه بـا عمـق بیشـتری بـه داخـل مـوادی بـا عـدد اتمـی کمتـر، نفـوذ

میکنند و توزیع الکترونی را به صورت یک ناحیه ی گلابی شـكل درمى آورنـد. افزايـش انـرژى فقـط طـول مسـير الكتروني را افزایش میدهد مانند پوششی که پهن میشود اما به همان شکل باقی میماند. اخیراً، امکان پیشبینی شکل این حجم با صحت بیشتر، با مشاهدات مستقیم مواد پلاستیکی که مورد بمباران الکترونی قرار گرفته و متحمل تغییرات شیمیایی زیادی میشوند، فراهم شدهاست که در آن بهطور غیرمستقیم از روش شبیهسازی شدهی مونت کارلو^{۱۵} استفاده شدهاست. این رویکردها نشانگر این هستند که در موادی با عدد اتمی کمتر، حجم اندرکنش، ابعادی در حد چند میکرومتر و عمق بیشتری نسبت به پهنا دارد که نتیجهی أن شـکل گلابـی مشـخص حجـم اندرکنـش اسـت. ایـن شـکل توضيح مىدهـد كـه پراكندگـى غيرالاسـتيک در عـدد اتمـى كمتر با اهميتتر است بنابراين، الكترونها قادر خواهند بود بدون پراکندگی قابل توجهی نفوذ کنند. اما در صورتی کے الکترون ها انرژی از دست بدهند، پراکندگی الاستیک مهمتر می شود و انحرافات افزایش یافته تا این که یک ناحیه ی پیازی شکل ایجاد شود. هر چه عدد اتمی افزایش یابد، طول مسیر الکترونی کاهش می یابد، زیرا پراکندگی الاستیک بیشتر شده و زوایای پراکندگی افزایش مییابند. از این رو، انحرافات مسیر الکترونی از پرتوی موازی شده به سرعت افزایش یافته و یک حجم اندرکنش با ناحیهی کروی شکل را پدید میآورند.

بخشی از پرتو الکترونی ورودی که دوباره به صورت BSE^{۱۰} ظاهر می شود (که به عنوان ضریب BSE شناخته شده و با η نشان داده میشود) با عدد اتمی نمونه افزایش می یابد و این امر با پراکندگی الاستیک در نزدیکی سطح نمونه ثابت باقی میماند. در صورتی که عدد اتمی افزایش یابد، انرژی نيز به سمت انرژی پرتوی ورودی E_0 افزایش مییابد. BSE این امر باعث کاهش وابستگی ח به جریان باریکه الکترونی یا ولتاژ شتابدهنده می شود؛ يعنى كاهـش جزئي مشاهده شده بهصورت افزایش ولتاژ دیده می شود، ضمن اینکه تمایل n به کاه ش جزئی در ولتاژه ای پایین برای عناصر سنگینتر نیز مشاهده شدهاست. تغییرات در حجم اندر کنش شرح داده شده در بالا، وضوح تصویر هر سیگنال BSE را مشخص می کند، زیرا پراکندگی الکترون های اولیه حجم قسمتی از سطح را که نشر BSE اتفاق میافتد، افزایش میدهد. از این رو، در صورتی که حجم اندر کنش با افزایش عدد اتمی کاهش یابد، نمونهها با عدد اتمی بالا باید تصاویر با وضوح بالاتری را ارائه دهند. گرچه وضوح تصوير BSE به مراتب بهتر از X-ray است اما نسبت به وضوح تصویر SE در مرتبهی پایینتری قرار دارند زیرا نشر SE از ناحیه ای کوچکتر و نزدیک به سطح حجم اندرکنش (شکل (۱)) اتفاق می افتد. بنابراین، برای یک تابش نرمال دارای سطح مقطع کروی، سطح مقطع شدت نشر SE به صورت گوسین^{۱۷} است و نسبت سیگنال به نویز^{۱۸} خیلی کوچکتری نسبت به نشر BSE را دارا است.



شــکل ۱: مقایســهی گســتره نفــوذ ($R_{S} \cdot R_{B} \cdot R_{N}$) و (الکتـرون ثانویــه، الکتـرون برگشــتی، پرتو ایکـس) برای ســیگنالهای نشــر الکترونهای ثانویــه، الکترونهـای برگشــتی و پرتـو ایکـس عناصـر بـا اعــداد اتمی پاییــن تا متوسـط.

BSE تشخيص الكترونهاى

دستگاه آشکارساز اورهارت-تورنلی^{۱۹} که در بیشتر میکروسکوپهای الکترونی روبشی برای جمعآوری الکترونهای ثانویه به کار میرود، به دلیل جهتدار بودن و انرژیهای بالاتر BSE، برای تشخیص BSE مناسب نیست. هر آشکارساز BSE باید به لحاظ شکل هندسی در برگیرنده ی یک زاویه فضایی شکل باشد تا امکان جمعآوری پخش نشر BSE را که شکلی کسینوسی دارد، داشته باشد.

در عمل، استفاده از پرتو معمولی ورودی اولیه که در آن، محل قرارگیری آشکارساز بهصورت عمودی بالای نمونهی هدف قرار دارد، خیلی رایج است. پرتو الکترونی با عبور از یک حفرهی کوچک آشکارساز به نمونه برخورد میکند.

امروزه بهطور عمده دو نوع آشکارساز BSE در دسترس است: آشکارساز فوتومولتی پلایر سوسوزن^{۲۰} و آشکارساز حالت جامد دیودی^{۲۱}. مزیت نسبی این دو دستگاه و اساس ساز و کار آنها در مقالات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

■ تشکیل تصویر BSE

سیستم تصویربرداری در SEM بر استفاده از لولهی پرتوی کاتدی^{۲۲} مبتنی است. تصویرسازی با این روش در تمام دستگاههای تصویری مانند انواع تلویزیونها و مانیتورها رایج بوده است و تا قبل از ابداع فناوری نمایش مبتنی بر استفاده از بلور مایع^{۳۲}، از عمومیت گستردهای برخوردار بود [۲].

تشکیل هـر تصویـر BSE در CRT دسـتگاه SEM، ماننـد تمامـی تصاویـر SEM اسـت. CRT همـگام بـا عبـور پرتـو الکترونـی روی نمونـهی هـدف اسـکن میشـود، بهطـوری کـه یـک تطابـق یـک بـه یـک بیـن هـر نقطـه از نمونـه و هـر جـزء

(پیکسل) از صفحه ینمایش به وجود می آید. شدت تصویر در هر پیکسل با تعداد الکترون های نشر شده از نقطه متناظر در نمونه ی هدف و همچنین کنتراست تصویر به سادگی از تفاوت شدت پیکسل به پیکسل به دست می آید. کیفیت تصاویر حقیقی به تعداد نویزهای حاضر بستگی دارد. نویز اساساً ضمن تولید سیگنال، یا در میان تقویت سیگنال تولید می شود و سطح آن معمولاً با افزایش شدت سیگنال و کاهش سرعت روبش پروب الکترونی کاهش می یابد. با این حال، نویز تصویر بیشترین کنتراست ممکن BSE را نشان می دهد.

سیگنال الکترونهای برگشتی BSE

🗖 عدد اتمی یا کنتراست Z

عدد اتمی یا کنتراست Z (شکل (۲)) راحتترین تصویر قابل دستیابی BSE است که از وابستگی ضریب نشر BSE (n) عدد اتمی نمونهی هدف ناشی می شود. نمونه هایی که فقط شامل یک فاز هستند، Z و n ثابت است بنابراین، تصویر BSE بدون هیچ کنتراستی دارای شدت یکنواختی است، در حالی که در نمونه های چند فازی، Z و n از یک فاز به فازی دیگر متفاوت هستند، بنابراین تصویر BSE شامل شدت ها و کنتراستهای متفاوتی است، طوری که فاز ها با Z بالاتر، روشن تر ظاهر می شوند (شکل (۳-الف)). تصاویر ES همان محدوده (شکل (۳-ب)) حاوی جزییات کمتر (به خصوص وقتی سطح نمونه پولیش شده باشد) هستند زیرا نشر SE به طور قابل ملاحظهای مستقل از Z است.



شــکل ۲: تصویر عــدد اتمی یـا Z– کنتراســت متاگری ویـک هورنفلس. کـه مــواد معدنـی حاضــر در نمونــه بــه ترتیــب روشــنایی عبارتنــد از: کوارتــز (Q)، مســکوویت (M) و بیوتیــت (B).

www.IJLK



شـکل ۲: (الـف): تصویر z- کنتراسـت یا عدد اتمـی BSE متاگری ویک با مواد معدنـی موجـود در نمونه به تر تیب روشــنایی: ماتریکـس کوار تز و مسـکوویت (بـرای اطلاعـات بیشـتر بـه شـکل (۲) مراجعـه کنیـد). اسـتارولیت پورفیروبلاسـتیک (S)، بیوتیت (B)، گارنت (G) و ماتریکس ایلمنیـت (I). شـکل را بـا آنچه کـه در معادلـهی (۲) پیش شـده یا آنچه که از شـکل (۴) اسـتنباط شـده مقایسـه کنید. (ب): تصویر همان ناحیه کـه بـا الکترونهای ثانویـه گرفته شدهاسـت. اثرات ناچیز z-کنتراسـت و از بیـن رفتـن توپوگرافی سـطح بـه دلیل اسـتفاده از نمونـهی پولیش داده شـده کامـلا مشـهود است. هـر دو تصویـر در ولتـاژ ۲۰ کیلو ولت گرفتـه شـده و نمونـه با کربن پوشـش داده شدهاسـت.

در نمونههای ناهموار و زبر، مشخصههای وابسته به نشر BSE میتواند برای تهیهی تصاویر توپوگرافی به کار روند اما این ناهمواری و زبری، Z-کنتراست تصویر را کاهش میدهد. عملکرد هر سیستم BSE در بررسی توپوگرافیکی نمونهها در نهایت به تفاوت Z بین اجزای فازها بستگی دارد. بهطور کلی برای BSE بهتر است تمامی نمونهها پولیش شوند از این رو باید از توپوگرافی سطح با استفاده از BSE

ارتباط بیـن Z و η بهطـور تجربـی بـرای عناصر بهصـورت زیر تعریف شدهاسـت:

$\eta = \frac{\ln Z}{6}$	$-\frac{1}{4} \ (Z \ge 10)$	معادلهی (۱)
--------------------------	-----------------------------	-------------

با ایـن حـال بیشـتر مـواد معدنـی، عناصـر خالـص نیسـتند و اغلـب ترکیبهـای پلیمـری هسـتند. در اینگونـه موارد لازم اسـت معادلـهی (۱) بـا ضريـب ميانگيـن وزنـی BSE تغييـر کند.

معادلهی (۲)

$$\bar{\eta} = \sum_{i=1}^{n} C_i \eta_i$$

در این معادله: C_i غلظت وزنی هر عنصر در ترکیب و n_i ضریب عنصری BSE و n تعداد عناصر موجود در نمونه است. برای مشاهدهی جزء حقیقی در تصویر کنتراست Z، برخی از تفاوتها در عدد اتمی باید نمایش داده شوند. برای دو مادهی معدنی A و B این کنتراست به صورت زیر مشخص می شود:

 $\delta = \frac{signal (max) - signal (min)}{signal (max)} \qquad (\texttt{T})$



سیکن ۲۰ را بط بین طریب ۵۵۵ (۱۱ و ۵۵۱ معدنی (2 و ۲۵ راهه) عناصر خالص و (ب) سینگ تشیکیل شیده از مواد معدنی. مقادیر و از برنامهی کامپیوتری MEATNO محاسبه شدهاست. تنوع در ترکیب شیمیایی باعث ایجاد گسترهای از و بنابرایین تنوع در می شیود که کنتراستهای متفاوتی را ایجاد میکنند.

معادلات (۱) و (۲) به صورت نمودار برای عناصر خالص و بعضی از ترکیبات معدنی رایج، در شکل (۴) نشان داده شده است. مقادیر آ و <u>7</u> با استفاده از برنامه کامپیوتری -MEAT NO به صورت زیر محاسبه شده اند:

$\bar{z} = \frac{\sum(N \ AZ)}{\sum(N \ A)}$	معادلهی (۴)
--	-------------

که در آن: N تعداد اتمهای هر عنصر با جرم اتمی A و عدد اتمی Z و NA∑ جرم مولکولی است. توجه به این نکته ضروری است که مواد معدنی متعلق به سری مواد محلول -جامد (آمفی بولها، پیروکسنها و غیره) گسترهای از ترکیبات را شامل می شوند که مقادیر آ و Z را به دست می دهد، از این رو، تصاویر z- کنتر است با شدتهای متفاوت را ناشی می شوند [۳].



اسکن و در هر بزرگنمایی در محدودهی دستگاه، تقریباً بلافاصله بهدست آورد. از این رو، آشکارساز BSE ابزاری سریع در تشخیص تعداد فازهای موجود در یک نمونه و روابط بین آنها است.

مقالات

پینوشت

- ۱. کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 - ۲. مهندسی برق الکترونیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 - ۳. مهندسی مواد متالورژی، مرکز پژوهش متالورژی رازی
- ۴. عضو کارگروه تخصصی میکروسکوپ الکترونی روبشی شبکه آزمایشگاهی

- 5. accelerated electron beam
- 6. Sample target
- 7. Elastic scattering
- 8. Inelastic scattering
- 9. Back scattered electron (BSE)
- 10. Condenser lens
- 11. resolution
- 12. Objective lens
- 13. Secondary electron (SE)
- 14. Interaction volume
- 15. Monte carlo simulation technique
- 16. BSE coefficient
- 17. Gaussian
- 18. Signal- to- noise
- 19. Everhart- Thornley
- 20. Scintillator- Photomultiplier
- 21. Solid- state detector
- 22. Cathode Ray Tube (CRT)
- 23. Liquid Crystal Display (LCD)
- 24. Z- contrast
- 25.Scintillator- Photomultiplier
- 26. Solid- state detector
- 27. Energy dispersive x-ray spectroscopy
- 28. Wavelength dispersive x-ray spectroscopy

مراجع

[1] http://serc.carleton.edu

[2] http://edu.nano.ir

[3] Lloyd. G. E., 1987, "Atomic number and crystallographic contrast images with the SEM: a review of backscattered electron techniques," Mineralogy Mag., 51. pp. 3-19

Backscattered Electron Detector Introduction in Scanning Electron Microscope

Abstract

Interaction of an accelerated electron beam with a sample target produces a variety of elastic and inelastic collisions between electrons and atoms within the trajectory of the incoming beam electrons when they interact with a target sample without significant change in their kinetic energy. Backscattered electrons (BSE) are incident electrons reflected back from a target specimen by elastic scattering and imaged with scanning electron microscope (SEM). BSE detectors are typically placed above the sample in the sample chamber based on the scattering geometry relative to the incident beam often with separate components for simultaneous collection of back-scattered electrons in different directions. BSE detectors above the sample collect electrons scattered as a function of sample composition.

Author

Mina Mohebimorad^{1,4*} Maryam Khosravi^{2,4} Gholamreza Dehghani^{3,4}

*M_mohebi32@yahoo.com

1. Master of Science in Organic Chemistry, Chemistry and Chemical Research Center of Iran

2. Electronic Engineering, Iran Polymer and Petrochemical Institute

 Material and Metallurgical Engineering, Razi Metallurgical Research Center
Iran laboratory network SEM Experts Workgroup



Keywords

backscattered electron, elastic scattering, contrast images, scanning electron microscope.